

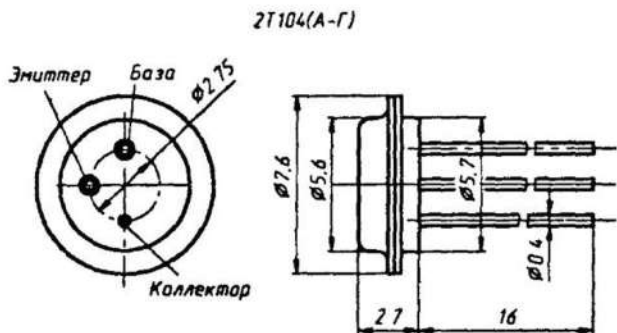
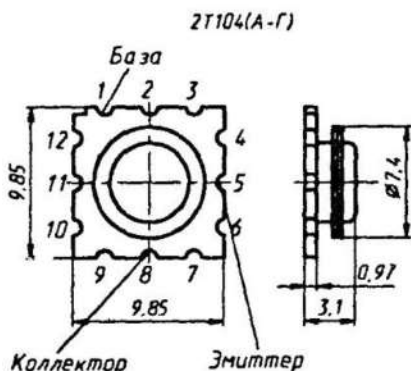
**2ТМ104А, 2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2ТМ104Г, 2Т104А,
2Т104Б, 2Т104В, 2Т104Г**

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* усилительные. Предназначены для применения в усилительных и импульсных этажерочных микромодулях заливной и капсулированной конструкции. Выпускаются в металло-

стеклянном корпусе на керамической плате (2ТМ104А–2ТМ104Г) и с гибкими выводами (2Т104А–2Т104Г). Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора на керамической плате не более 0,8 г, с гибкими выводами не более 0,5 г.

Изготовитель — акционерное общество «Крейнний», г. Брянск.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 1 \text{ В}$, $I_{К} = 10 \text{ мА}$:

2ТМ104А, 2Т104А	7...40
2ТМ104Б, 2Т104Б	15...80
2ТМ104В, 2Т104В	19...160
2ТМ104Г, 2Т104Г	10...60

Коэффициент передачи тока в режиме малого
сигнала при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$, $I_{Б} = 1 \text{ мА}$:

$T = +25 \text{ }^\circ\text{C}$:

2ТМ104А, 2Т104А	9...36
2ТМ104Б, 2Т104Б	20...80
2ТМ104В, 2Т104В	40...160
2ТМ104Г, 2Т104Г	15...60

$T = +125 \text{ }^\circ\text{C}$:

2ТМ104А, 2Т104А	9...108
2ТМ104Б, 2Т104Б	20...240
2ТМ104В, 2Т104В	40...380
2ТМ104Г, 2Т104Г	15...180

$T = -60 \text{ }^\circ\text{C}$:

2ТМ104А, 2Т104А	7...36
2ТМ104Б, 2Т104Б	13...80
2ТМ104В, 2Т104В	25...160
2ТМ104Г, 2Т104Г	10...60

Граничная частота коэффициента передачи
тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 0,5 \text{ В}$, $I_{Б} = 1 \text{ мА}$,

не менее 5 МГц

Граничное напряжение, не менее:

при $I_{Б} = 5 \text{ мА}$ для 2ТМ104А, 2ТМ104Г, 2Т104А, 2Т104Г	30 В
при $I_{Б} = 10 \text{ мА}$ для 2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2Т104Б, 2Т104В	15 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер

при $I_{К} = 10 \text{ мА}$, не более:

при $I_{Б} = 2 \text{ мА}$ для 2ТМ104А, 2Т104А	0,5 В
при $I_{Б} = 1 \text{ мА}$ для 2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2ТМ104Г, 2Т104Б, 2Т104В, 2Т104Г	0,5 В

Напряжение насыщения эмиттер—база

при $I_{К} = 10 \text{ мА}$, не более:

при $I_{Б} = 2 \text{ мА}$ для 2ТМ104А, 2Т104А	1 В
при $I_{Б} = 1 \text{ мА}$ для 2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2ТМ104Г, 2Т104Б, 2Т104В, 2Т104Г	1 В

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = U_{КБ, \text{МАКС}}$
не более:

$T = +25$ и -60 °C	1 мкА
$T = +125$ °C	15 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = U_{эб, макс}$, не более:	
$T = +25$ и -60 °C	1 мкА
$T = +125$ °C	10 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 5$ В, $f = 3$ МГц, не более	50 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0,5$ В, $f = 10$ МГц, не более	10 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база и коллектор—эмиттер при $R_{бэ} \leq 10$ кОм или $U_{эб} = 0,5$ В:	
при $T = -60...+75$ °C для 2ТМ104А, 2ТМ104Г, 2Т104А, 2Т104Г	30 В
2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2Т104Б, 2Т104В	15 В
при $T = +125$ °C для 2ТМ104А, 2ТМ104Г, 2Т104А, 2Т104Г	20 В
2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2Т104Б, 2Т104В	10 В
Постоянное напряжение эмиттер—база:	
$T = -60...+75$ °C	10 В
$T = +125$ °C	5 В
Постоянный ток коллектора:	
$T = -60...+75$ °C	50 мА
$T = +125$ °C	30 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора ¹ :	
$T = -60...+60$ °C	150 мВт
$T = +125$ °C	41,6 мВт
Тепловое сопротивление переход—среда	0,6 °C/мВт
Температура $p-n$ перехода	+150 °C
Температура окружающей среды	-60...+125 °C

¹ При $T = +60...+125$ °C максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора определяется по формуле

$$P_{к, макс} = (150 - T)/0,6, \text{ мВт.}$$